

2021年10月27日(水)

シンポジウム 10月27日(水) 13:00~16:55

JCCG-50バルク成長分科会シンポジウム「ワイドバンドギャップ材料の結晶成長の最前線」

(座長：太子敏則/信州大, 吉村政志/阪大)

13:00		はじめに		
13:05	27s-C09	ポイントシード技術を用いたNaフラックス法による高品質・大口径GaNウエハの作製	今西正幸, 村上航介, 宇佐美茂佳, 丸山美帆子, 吉村政志, 森勇介	阪大院工, 阪大レーザー研
13:35	27s-C10	超低抵抗・低転位密度GaN基板の開発とデバイス応用	滝野淳一, 隅智亮, 宇佐美茂佳, 今西正幸, 岡山芳央, 森勇介	パナソニック, 阪大
14:05	27s-C11	トリハライド気相成長法によるGaN結晶成長	村上尚, 纈纈明伯	農工大
14:50	27s-C12	低転位密度AlNテンプレート上でのAlGaN成長におけるステップ制御	三宅秀人, 上杉謙次郎, 肖世玉, 正直花奈子, 窪谷茂幸	三重大
15:20	27s-C13	溶液法による6インチSiC結晶成長	宇治原徹	名大未来研, UJ-Crystal, 産総研GaN-OIL
15:50	27s-C14	MOVPE法による β -Ga ₂ O ₃ 薄膜成長の検討	熊谷義直, 西村太郎, 田中那実, 池永和正, 石川真人, 町田英明, 後藤健	農工大, 大陽日酸, 気相成長
16:20	27s-C15	量子デバイス応用のためのダイヤモンド結晶成長	寺地徳之	物材機構
16:50		おわりに		

16:55 終了